## LUMINESCENT ELEMENT AND IRIDIUM COMPLEX

Publication number: JP2002117978 (A)

Publication date:

2002-04-19

Inventor(s):

IGARASHI TATSUYA; ISE TOSHIHIRO; MIYASHITA YOSUKE; FUJIMURA

HIDETOSHI; OKADA HISASHI; MISHIMA MASAYUKI; KYU SETSUHO

Applicant(s):

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

H01L51/50; C07D213/61; C07F15/00; C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14;

H01L51/50; C07D213/00; C07F15/00; C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14; (IPC1-

7); C07F15/00; H05B33/14; C07D213/61; C09K11/06; H05B33/10

- European:

Application number: JP20010189539 20010622

Priority number(s): JP20010189539 20010622; JP20000216338 20000717

## Abstract of JP 2002117978 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a luminescent element capable of emitting highluminance blue luminescence over a long period and having an excellent luminescence characteristic and provide an iridium complex allowing it. SOLUTION: This luminescent element has characteristics including the external quantum efficiency of 5% or above and the luminescence maximum wavelength &lambda max of 500 nm or below. At least one of the lavers of the luminescent element having a luminescent layer or a plurality of organic compound layers including the luminescent layer between a pair of electrodes includes at least one of the compounds having the partial structure expressed by the general formula K-0, wherein, R1-R7 independently indicate a hydrogen atom or a substitutional group, R3 is not the hydrogen atom when R2 is a fluorine atom.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002—117978 (P2002—117978A)

(43)公開日 平成14年4月19日(2002.4.19)

識別記号	FI	テーマュート*(参考)
	H 0 5 B 33/14	B 3K007
	C 0 7 D 213/61	4 C 0 5 5
660	C09K 11/06	660 4H050
	H 0 5 B 33/10	
# CO7F 15/00	C07F 15/00	E
	次請末 朱龍壹審	<b>請求項の数11 OL (全 17 頁)</b>
特額2001-189539(P2001-189539)	(71)出職人 0000052	201
	會士事	真フイルム株式会社
(22)出顧日 平成13年6月22日(2001, 6, 22)	神奈川	幕南足柄市中招210番地
	(72)発明者 五十嵐	逢也
特顯2000-216338(P2000-216338)	神奈川県南足栖市中沼210番地 富士写真	
平成12年7月17日(2000.7.17)	フイルム株式会社内	
(33)優先権主張国 日本 (JP)	(72)発明者 伊勢	<b>发</b> 大
	神奈川	幕南足柄市中沼210番地 富土写真
	フイル	<b>心株式会社内</b>
	(74)代理人 1000790	049
	<b>弁理士</b>	中島 淳 (外3名)
	特額2001-189539(P2001-189539) 平成13年6月22日(2001.6.22) 特額2000-216338(P2000-216338) 平成12年7月17日(2000.7.17)	日本 (J P) (72)発明者 伊勢 (72)発明者 (72)発明者 (72)発明者 (72)発明者 (72)発明者 (73) (73) (73) (73) (74) (74) (74) (74) (74) (74) (74) (74

## (54) 【発明の名称】 発光素子及びイリジウム錯体

# (57) 【要約】

【課題】 高輝度の青色発光を長時間発光可能な発光特性に優れた発光素子およびそれを可能とするイリジウム 錯体を提供する。

【解決手段】 外部量子効率が5%以上で、且つ発光極 大波長えmaxが500nm以下の特性を有する発光素 子である。また、一対の電極間に、発光層もしくは発光 層を含む複数の有機化合物層を有する発光素子におい て、これらの層の少なくとも一層に、下記一般式K-0 で表される部分構造を有する化合物を少なくとも一種含 むことを特徴とする発光素子である。一般式K-0中、 R'~R'は各々独立に、水素原子または置換基を表す。 但し、R'がフッ素原子の場合は、R'は水素原子である ことはない。

# 【化1】

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部量子効率が5%以上で、且つ発光極 大波長âmaxが500nm以下の特性を有することを 特徴とする発光素子。

1

【請求項2】 20℃におけるりん光量子収率が70% 以上で、且つりん光の発光極大波長âmaxが500n m以下である発光材料を含有することを特徴とする発光 素子。

【請求項3】 一対の電極間に、発光層もしくは発光層 を含む複数の有機化合物屬を有する発光素子において、 10 これらの圏の少なくとも一層に、下記一般式K-0で表 される部分構造を有する化合物を少なくとも一種含むこ とを特徴とする発光素子。

#### 【他1】

(一般式K-0中、R'~R'は各々独立に、水素原子ま たは置換基を表す。但し、R<sup>®</sup>がフッ素原子の場合は、 R<sup>®</sup>は水素原子であることはない。)

【請求項4】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化合物が、下記一般式KーIで表される部分構造 を有する化合物である請求項3に記載の発光素子。

## [452]

(一般式K-I中, R"~R"は各々独立に、水素原子 または置換基を表す。)

【請求項5】 下記一般式K-IIで表されることを特徴 40 とするイリジウム錯体。

## [化3]

# --般式K--||

(一般式K-II中、R"~R"は各々独立に、水素原子 または置換基を表す。 $L^{2i}$  は配位子を表す。 $n^{2i}$  は1~ 3の整数を表し、n<sup>2</sup> は0~4の整数を表す。)

【請求項6】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化合物が、下記一般式K-111で表される部分構 造を有する化合物である請求項3に記載の発光素子。

#### 【化4】

20

30

(一般式K-III中、R" ~ R" は各々独立に、水素原 子または置換基を表す。)

【請求項7】 下記一般式K-IVで表されることを特 徴とするイリジウム錯体。

## 【化5】 マーン大会一

 $(一般式K-IV中、<math>R''\sim R''$  は各々独立に、水素原 子または置換基を表す。L" は配位子を表す。n" は 1 ~3の整数を表し、n は0~4の整数を表す。

【請求項8】 前記一般式K-0で表される部分構造を 有する化合物、前記一般式K-1で表される部分構造を 有する化合物、前記一般式KーIIで表されるイリジウム 錯体、前記一般式K-IIIで表される部分構造を有する 化合物、及び前記一般式KーIVで表されるイリジウム 錯体の少なくとも一種を含有する請求項1に記載の発光 50 素子。

【請求項9】 前記20℃におけるりん光量子収率が7 0%以上で、且つりん光の発光極大波長 lmaxが50 Onm以下である発光材料が、前記一般式K-Oで表さ れる部分構造を有する化合物、前記一般式KーIで表さ れる部分構造を有する化合物、前記一般式KーIIで表さ れるイリジウム錯体、前記一般式K…IIIで表される部 分構造を有する化合物、及び前記…般式K…IVで表さ れるイリジウム錯体の少なくとも一種である請求項2に 記載の発光素子。

ロセスで成膜されている請求項2又は9に記載の発光素

【請求項11】 前記一般式K-0で表される部分構造 を有する化合物を含有する屬が、塗布プロセスで成膜さ れている請求項3、4、6及び8のいずれかに記載の発 光素平。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なイリジウム 錯体およびこれを利用した発光素子に関し、特に詳細に 20 は、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写 真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標 識、看板、インテリア、光通信等の分野に好適に使用可 能な新規なイリジウム錯体およびこれを利用した発光素 子に関する。

## [0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表 示案子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 30 着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている (アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 3頁、1987年)。前記文献に記載の発光素子は、ト リス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体 (Alq)を電子輸送材料として用い、該電子輸送材料 を含有する層と、正孔輸送材料(アミン化合物)を含有 する層とを積層した構成であり、従来の単層型素子と比 戦して発光特性を大幅に向上させることが可能である。 近年、有機EL素子をカラーディスプレイおよび白色光 源へ適用することが活発に検討されている。有機EL素 40 子を前記用途に供するには、靑・緑・赤の各々に発光可 能な発光素子それぞれについて、輝度および発光寿命等 の発光特性を向上させる必要がある。

【0003】ところで、発光特性が改善された発光素子 として、オルトメタル化イリジウム錯体 (Ir(ppy): Tr is-Ortho-Metalated Complex of Iridium(III) with 2-Phenylpyridine)からの発光を利用した発光素子が報告 されている(Applied PhysicsLetters, 75,4(199 9)、)。従来、発光素子はその外部量子効率について

は、5%が限界であるといわれていたが、前記文献に記 50

載の発光素子は外部量子効率8%を達し、従来の限界を 超えるものである。しかし、前記発光素子から得られる 発光は、緑色発光に限られる為、ディスプレイとしての 適用範囲は狭い。他色についても発光特性が改善された 発光素子が提供できれば、ディスプレイとしての適用範 囲も拡大されるので、他色の発光素子についても発光特 性の改善が望まれている。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】ここで、青色発光素子 【請求項10】 - 前記発光材料を含有する層が、塗布プ - 10 - に着目してみると、DPVB : (4, 4'ーピス(2, 2'ージフェニルビニル)ービフェニル)などに代表さ れるジスチリルアリーレン誘導体及びその類縁体を用い た発光素子等が多数報告されている。しかし、青色発光 素子については、外部量子効率5%を超える案子は未だ 報告されていないのが実状である。青色発光について も、外部量子効率が5%を超える発光素子が提供できれ ば、高効率有機EL素子のカラー化、及び白色化が可能 となり、用途拡大へ大きく前進する。また、表示素子に 利用した場合に、発光の消費電力を大幅に下げることが できるとともに、大面積化および長時間使用が可能とな

> 【0005】本発明は、前記諸問題に鑑みなされたもの であって、発光時の消費エネルギーを軽減できるととも に、高輝度の青色発光を長時間発光可能な発光特性に優 れた発光素子を提供することを課題とする。また、本発 明は、長期間にわたって高輝度の青色発光を示す発光特 性に優れたイリジウム錯体およびこれを利用した発光素 子を提供することを課題とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため の手段は以下の通りである。即ち、

<1> 外部量子効率が5%以上で、且つ発光極大波長 λmaxが500nm以下の特性を有することを特徴と する発光素子である。

<2> 20℃におけるりん光量子収率が70%以上 で、且つりん光の発光極大波長えmaxが500nm以 下である発光材料を含有することを特徴とする発光素子 である。

<3> 一対の電極間に、発光層もしくは発光層を含む 複数の有機化合物層を有する発光素子において、これら の層の少なくとも一層に、下記一般式K-0で表される 部分構造を有する化合物を少なくとも一種含むことを特 徴とする発光素子である。

#### [0007]

# [{E6]

【0008】(一般式K-0中、R<sup>1</sup>~R<sup>2</sup>は各々独立に、水素原子または置換基を表す。但し、R<sup>2</sup>がフッ素原子の場合は、R<sup>2</sup>は水素原子であることはない。) <4> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する化合物が、下記一般式K-1で表される部分構造を有する化合物である前記<3>に記載の発光素子である。

[0009]

[化7]

【0.0.1.0】 (一般式K--1中、 $R'' \sim R''$  は各々独立 に、水素原子または微検基を表す。)

〈5〉 下記一般式KーHで表されることを特徴とする イリジウム錯体である。

[0011]

[[E8]

一般式K一川

【0012】 (一般式K-II中、 $R^n \sim R^n$  は各々独立に、水素原子または置換基を表す。 $L^n$  は配位子を表す。 $n^n$  は $1 \sim 3$  の整数を表し、 $n^n$  は $0 \sim 4$  の整数を表す。)

< 6> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する 化台物が、下記一般式K-IIIで表される部分構造を有 する化合物である前記<3>に記載の発光素子である。

[0013]

[他9]

【0014】 (一般式K-Hi中、R"~R\*は各々独 10 立に、水素原子または置換基を表す。)

<7> 下記一般式KーIVで表されることを特徴とするイリジウム錯体である。

[0015]

[化10] 一般式K-N

【0016】(一般式K-IV中、R<sup>n</sup> ~R<sup>n</sup> は各々独立に、水素原子または懺換基を表す。L<sup>n</sup> は配位子を表す。n<sup>n</sup> は1~3の整数を表し、n<sup>n</sup> は0~4の整数を表す。

<8> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する 0 化合物、前記一般式K-Iで表される部分構造を有する 化合物、前記一般式K-IIで表されるイリジウム錯体、 前記一般式K-IIで表される部分構造を有する化合 物、及び前記一般式K-IVで表されるイリジウム錯体 の少なくとも一種を含有する前記<1>に記載の発光素 子である。

< 9> 前記20℃におけるりん光量子収率が70%以上で、且つりん光の発光極大波長2maxが500nm以下である発光材料が、前記一般式K-0で表される部分構造を有する化合物、前記一般式K-11で表される部分構造を有する化合物、前記一般式K-IIで表されるイリジウム錯体、前記一般式K-IIで表されるイリジウム錯体、前記一般式K-IIで表されるイリジウム錯体の少なくとも一種である前記<2>に記載の発光素子である。

< 10> 前記発光材料を含有する層が、塗布プロセスで成膜されている前記< 2>または< 9>のいずれかに記載の発光素子である。

<11> 前記一般式K-0で表される部分構造を有する化合物を含有する層が、塗布プロセスで成膜されている的記<3>、<4>、<6>及び<8>のいずれかに

記載の発光素子である。

#### [0.017]

【発明の実施の形態】本発明の発光素子は、外部量子効 率5%以上の高い発光効率で、発光極大波長 2 m a x が 500 nm以下の青色発光を示すことを特徴とする。従 って、本発明の発光素子は発光時の消費エネルギーを軽 減できるとともに、高輝度の青色発光を長時間発光可能 である。また、特に表示素子に利用した場合には、大面 額化が可能となる。尚、ここで、外部量子効率とは、以 下の式により算出される値をいう。発光素子の外部量子 10 光量子収率の高い材料を用いるのが好ましい。具体的に 効率の算出方法としては、発光輝度、発光スペクトル、 比視感度曲線および電流密度から算出する方法と、電流 密度および発光された全フォトン数から算出する方法と がある。

外部量子効率(%) == (発光された全フォトン数/発光 素子に注入された電子数)×100

【0018】前記発光素子の外部量子効率は好ましくは 7%以上、より好ましくは10%以上である。また、本 発明の発光素子は、青色色純度の観点から、発光極大波 長えmaxが好ましくは390mm以上495mm以下 20 が発光する化合物であり、例としては、遷移金溪錯体 であり、より好ましくは400nm以上490nm以下 であり、更に好ましくは420 nm以上480 nm以下 である。尚、本発明の発光素子は、発光極大波長が50 0 n m以下にあれば青色領域以外の波長域、例えば、紫 外領域、緑色領域、赤色領域のいずれかにも発光を有し ていてもよい。

【0019】前記発光素子は、発光色の青色色純度の観 点から、発光のCIE色度値のx値およびy値は小さい 程好ましい。具体的には、発光のCIB色度値のx値は 0、22以下であるのが好ましく、0.20以下である。 のがより好ましい。また、発光のCIE色度値のy値は 0.53以下であるのが好ましく、0.50以下である のがより好ましく、0、40以下であるのが更に好まし

【0020】前記発光素子は、青色色純度の観点から、 発光スペクトルの半値幅が1 n m以上100 n m以下で あるのが好ましく、5 nm以上90 nm以下であるのが より好ましく、10nm以上80nm以下であるのがさ らに好ましく、20nm以上70nm以下であるのが特 に好ましい。

【0021】前記発光素子は、システム、駆動方法、利 用形態など特に問わないが、その実施形態としてEL (エレクトロルミネッセンス)素子を挙げることができ る。EL素子の一構成例としては、陽極と陰極の一対の 電極間に、1以上の発光層を形成した発光素子が挙げら れる。その他、前記電極間に発光層の他、正孔注入層、 正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層および保護層のい ずれか1以上を有する発光索子が挙げられる。またこれ らの各層が、それぞれ他の機能を備えたものであっても よい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いること 50

ができる。本発明の発光素子は、有機発光素子であるこ とが好ましい。ここで、有機発光素子とは、発光をつか さどる物質が有機化合物であるものを言う。

【0022】前記発光素子には、陰極と発光層との間に イオン化ポテンシャル5.9 e V以上(より好ましくは 6.0eV以上7.0eV以下)の化合物を含有する層 を配置するのが好ましく、イオン化ポテンシャル5、9 e V以上の電子輸送層を配置するのがより好ましい。

【0023】前記発光素子には、発光材料として、りん は、20℃でのりん光量子収率が70%以上で、且つり ん光の発光極大波長 l m a x が 5 0 0 n m以下の発光材 料が好ましく、20℃でのりん光量子収率が80%以上 で、且つりん光の発光極大波長えmaxが490nm以 下の発光材料がより好ましく、20℃でのりん光量子収 率が85%以上、且つりん光の発光極大波長1maxが 480 nm以下の発光材料がさらに好ましい。

【0024】前記発光材料とは、発光素子の発光層もし くは発光層を含む有機化合物層に含有されて、それ自身 (好ましくはオルトメタル化錯体) が好ましく、中で も、イリジウム錯体および白金錯体がより好ましく、オ ルトメタル化イリジウム錯体がさらに好ましく、後述す る一般式K-0で表される部分構造を有する化合物が特 に好ましい。

【0025】ここで、オルトメタル化錯体 (orthometal ated Complexes)とは、例えば「有機金属化学-基礎と 応用一」p 150, 232 裳華廣社 山本明夫著 19 82年発行、「Photochemistry and Photophysics of C coordination Compounds) p71-p77, p135-p146 Springer -Verlag社 H. Yersin著1987年発行等に記載されてい る化合物群の総称である。

【0026】前記発光素子は、下記一般式K-0で表さ れる部分構造を有する化合物(以下、「イリジウム化合 物」という場合がある)を発光材料として含有するのが 好ましく、前記イリジウム化合物の中でも、りん光量子 収率およびりん光の発光極大波長Amaxが前述の範囲 である化合物を含有するのが好ましい。以下、下記一般 式K-0に関して詳細に説明する。なお、本発明におけ る発光材料は、発光素子の発光層もしくは発光層を含む 複数の有機化合物層に含有されることで機能する。

[0027]

(化11]

一般式K-0 R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> R<sup>5</sup> R<sup>6</sup>

【0028】R'~R'は各々独立に、水素原子または置換基を表す。但し、R'がフッ素原子の場合は、R'は水 10 い。素原子であることはない。置換基としては、後述の一般式K-1におけるR"で説明する基が挙げられる。R'は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、フッ素原子、アルキル基である。R'は好ましくは水素原子、フッ素原子、アルキル基である。R'は好ましくは水素原子、フッ素原子、アルキル基である。R'は好ましくは水素原子、フッ素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、フッ素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、フッ素原子であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子であり、更に好ましくはフッ素原子である。 26 構造

【0029】R<sup>®</sup>は好ましくは水素原子、アルキル基、 置換または無置換のアミノ基、アルコキシ基であり、よ り好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基であ り、更に好ましくは水素原子である。R<sup>®</sup>、R<sup>®</sup>及びR<sup>®</sup> は好ましくは水素原子、アルキル基であり、より好まし くは水素原子である。

【0030】前記イリジウム化合物におけるイリジウム原子の価数は、特に限定されるものではないが、3価が好ましい。また、前記イリジウム化合物は、イリジウム原子を1つ含むいわゆる単核錯体であってもよい。中でも、イリジウム原子を1つ含む単核錯体が好ましい。また、前記イリジウム化合物は、イリジウム以外の他の金属原子を含んでいてもよいが、中心金属がイリジウムのみである化合物が好ましい。

【0031】前記イリジウム化合物は、構造中に種々の配位子を有することができる。前記配位子としては、例えば、「Photochemistry and Photophysics of Coordin ation Compounds」 Springer-Verlag社 fl. Yersin著 1987年発行、「有機金属化学-基礎と応用ー」 裳華房社 由本明夫著 1982年発行 等に記載の配位子が幸げられる。前記配位子としては、単座配位子であっても、2座配位子等の多座配位子であってもよい。前記配位子としては、ハロゲン配位子(好ましくは塩素配位子)、含窒素ヘテロ環配位子(例えばフェニルビリジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビビリジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子、アナールンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子、アナールンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子、アナールンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子、アナールンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子、アナールアセトン等)がより好ましい。前記イリジウム化合物に含まれる配位子は、1667年また。

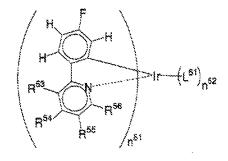
あってもよい。前記イリジウム化合物中の配位子の種類は、好ましくは1および2種類であり、特に好ましくは1種類である。また、前記イリジウム化合物は、電荷を有さない中性錯体でもよいし、対塩(例えば塩素イオン、PF。イオン、C1O、イオン)を有するイオン性錯体であってもよい。中でも、中性錯体が好ましい。

【0032】前記イリジウム化合物に含まれる炭素数は 15~100であるのが好ましく、20~70であるの がより好ましく、30~60であるのがさらに好まし い。

【0033】一般式K-0で表される部分構造を有する 化合物の好ましい形態は、一般式K-ITで表される部分 構造を有する化合物、または、一般式K-ITで表され る部分構造を有する化合物であり、より好ましい形態 は、一般式K-ITで表される部分構造を有する化合物 である。一般式K-Iで表される部分構造を有する化合物は、より好ましくは一般式K-ITで表されるイリジウム錯体であり、より好ましくは一般式K-Vで表されるイリジウム錯体である。一般式K-ITで表される部分 20 構造を有する化合物は、より好ましくは一般式K-IV で表されるイリジウム錯体であり、より好ましくは一般 式K-VIで表されるイリジウム錯体である。

[0034]

【化12】 一般式K-V



【0035】 【化13】 一般式K-V

ナントロリンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位 【0036】次に、一般式K-1について説明する。前子、PF。配位子が好ましく、ジケトン配位子(アセチ 記一般式K-1中、R およびR は各々独立して、水ルアセトン等)がより好ましい。前記イリジウム化合物 素原子または置換基を表す。置換基としては、例えば、に含まれる配位子は、1 種類でもよいし、2 種類以上で 50 アルキル基(好ましくは炭素数  $1 \sim 30$ 、より好ましく

は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、例えばメチル、エチル、iso一プロピル、tertーブチル、nーオクチル、nーデシル、nーペキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロペンチル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロペンチル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロペンチルを送水数2~30、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばプロペルギル、3~ペンチニルなどが挙げられる。)、アルキニルなどが挙げられる。)、例えばプロペルギル、3~ペンチニルなどが挙げられる。)、

【0037】アリール基(好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数 6~12であり、例えばフェニル、p-メチルフェニ ル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられる。)、ア ミノ糕(好ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭 素数0~20、特に好ましくは炭素数0~10であり、 例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチ ルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジト 20 リルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシ蓋(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~10であり、例えばメト キシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシロキシな どが挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭 素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好 ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルオキ シ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシなどが挙 げられる。)、ヘテロアリールオキシ基(好ましくは炭 素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好 30 ましくは炭素数1~12であり、例えばピリジルオキ ン、ビラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキ ンなどが挙げられる。)、

【0038】アシル基(好ましくは炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミ ル、ピバロイルなどが挙げられる。)。アルコキシカル ボニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは 炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12であ り、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニルな 40 どが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好 ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素数7~2 0、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェ ニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシルオ キシ藍(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭 素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、 例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられ る。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~30、 より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数

ミノなどが挙げられる。)、

【0039】アルコキシカルボニルアミノ基(好ましく は炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特 に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカ ルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシ カルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~30、より 好ましくは炭素数7~20、特に好ましくは炭素数7~ 12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノな どが挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは - 10 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に 好ましくは炭素数1~12であり、例えばメクンスルホ ニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられ る。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~3 0、より好ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭 素数0~12であり、例えばスルファモイル、メチルス ルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスル ファモイルなどが挙げられる。)、カルバモイル基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカル バモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイ ル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アル キルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメチルチオ。エチルチオなどが挙げられ る。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20。特に好ましくは炭素数 6~12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられ S.)

【0040】ヘテロアリールチオ墓(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばピリジルチオ、2~ ベンズイミブリルチオ、2ーベンズオキサブリルチオ、 2ーペンズチアゾリルチオなどが挙げられる。)、スル ホニル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは 炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。)、スル フィニル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばメタンスルフィニル、バンゼンスルフィニル などが挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばウレイド、メチルウ レイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。)、リン 酸アミド基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミ 下などが挙げられる。)、

る。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~30、 【0041】ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原 より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数 子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 2~10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルア 50 子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ 基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(脂肪族へテロ環基、ヘテロアリール基が挙げられ、好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾリルなどが挙げられる。)、シリル基(好ましくは炭素数3~24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる。)などが挙げられる。これらの置換基は更に置換されてもよい。

【0042】前記一般式K-I中、R<sup>1</sup> は水素原子、アルキル基、アリール基またはヘテロアリール基であるのが好ましく、水素原子であるのがより好ましい。前記一般式K-I中、R<sup>1</sup> は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基またはフッ素原子であるのが好ましく、水素原子またはフッ素原子であるのがより好ましく、フッ素原子であるのがさらに好ましい。

【0043】前記一般式K-I中、R"~R"は各々独立に、水素原子または置換基を表す。置換基が結合して環構造を形成してもよい。置換基としては前記R"の基が挙げられる。前記一般式K-I中、R"は水素原子、アルキル基、置換もしくは無置換のアミノ基、またはアルコキン基であるのが好ましく、水素原子、アルキル基、またはアルコキン基であるのがより好ましく、水素原子であるのが特に好ましい。前記一般式K-I中、R"れよびR"は夫々、水素原子またはアルキル基であるのが好ましく、水素原子またはアルキル基であるのが好ましく、水素原子であるのがより好ましい。

【0045】一般式K-II中、L<sup>®</sup> は配位子を表し、配位子としては、例えば、「Photochemistry and Photoph ysics of Coordination Compounds」 Springer-Verlag 社 B. Yersin著 1987年発行、「有機金属化学-基礎 40と応用…」 袋華房社 山本明夫著 1982年発行 等に配載の配位子が挙げられ、好ましくは、ハロゲン配位子(好ましくは塩素配位子)、含窒素ペテロ環配位子(例えばフェニルビリジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビビリジル、フェナントロリンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位子であり、より好ましくは含窒素ペテロ環配位子、ジケトン配位子である。

【0046】 $n^{**}$ は1~3の整数を表し、より好ましくは1または2である。 $n^{**}$ は0~4の整数を表し、より好ましくは0または1である。

【0047】次に、一般式K-IIIについて納明する。一般式K-III中、R"およびR"は各々独立に、水素原子または置換基を表す。置換基としては前配一般式K-IにおけるR"の基が挙げられる。R"は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基であり、より好ましくは水素原子である。R"は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、フッ素原子であり、より好ましくは水素原子、フッ素原子であり、さらに好ましくは水素原子である。

【0048】一般式K-III中、R\*\* ~R\*\* は各々独立に、水素原子または置換基を表す。置換基が結合して環構造を形成してもよい。置換基としては前記一般式K-IにおけるR\*\* の基が挙げられる。R\*\* は好ましくは水素原子、アルキル基、置換もしくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子である。R\*\*、R\*\* およびR\*\* は、好ましくは水素原子、アルキル基であり、より好ましくは水素原子である。

【0049】次に、一般式K-IVについて範囲する。 一般式K-IV中、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup> およびR<sup>\*</sup>は、それぞれ前記一般式K-IIIにおけるR<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>なよびR<sup>\*</sup>と同義であり、好ましい範囲も同じである。L<sup>\*</sup>は前記一般式K-IIにおけるL<sup>\*</sup>と同義であり、好ましい範囲も同じである。n<sup>\*</sup>は1~3の整数を表し、好ましくは1または2である。n<sup>\*</sup>は0~4の整数を表し、0または1が好ましい。

【0.050】次に、-般式K-Vについて説明する。-般式K-V中、 $R^n$ 、 $R^n$ 、 $R^n$ 、 $R^n$ 、 $R^n$ 、 $R^n$  、 $R^$ 

【0051】次に、一般式K-VIについて説明する。 一般式K-VI中、 $R^{80}$ 、 $R^{80}$ 、 $R^{80}$ 、 $R^{80}$ 、 $L^{10}$ 、 $n^{80}$  および $n^{80}$  は、それぞれ前記一般式K-IVにおける  $R^{80}$ 、 $R^{80}$ 

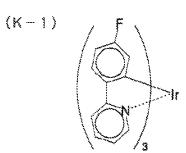
【0052】尚、前記イリジウム化合物は、いわゆる低分子化合物であっても、また前記一般式K-0で表される部分構造を有する繰り返し単位を含む、いわゆるオリゴマー化合物およびボリマー化合物(質量平均分子量(ポリスチレン換算)は好ましくは1000~500000、さらに好ましくは3000~10000である。)であってもよい。中でも、前記イリジウム化合物は低分子化合物であるのが好ましい。

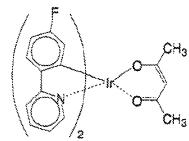
【0053】以下に、前記一般式K-0で表される部分 構造を有するイリジウム化合物の化合物例(K-1~K -25)を示すが、本発明はこれらに限定されるもので はない。

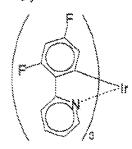
[0054]

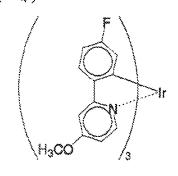
30

[张14]

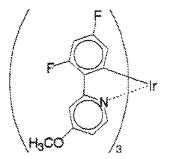


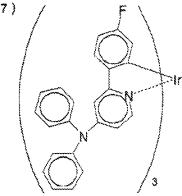






(9)

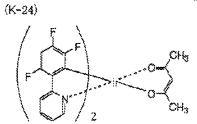




【化15】

[化16]

【0057】前記一般式ドー0で表される部分構造を有 する化合物は、種々の手法で合成することができる。例 えば、種々の配位子またはその解離体とイリジウム化合 物とを、溶媒(例えば、ハロゲン系溶媒、アルコール系 浴媒、エーテル系溶媒、水などが挙げられる)の存在下 もしくは溶媒非存在下、塩基の存在下 (無機、有機の種 々の塩基、例えば、ナトリウムメトキサイド、モーブト キシカリウム、トリエチルアミン、炭酸カリウムなどが 挙げられる)もしくは塩基非存在下、室温以下もしくは 加熱して(通常の加熱以外にもマイクロウェーブで加熱 50



する手法も有効である)、合成することができる。出発 原料としては、例えば、イリジウムクロライド(II I)、トリスアセチルアセトナトイリジウム(III)、ポ タシウムヘキサクロロイリデート (III) 、ポタシウム ヘキサクロロイリデート (IV) 及びその類縁体を用いる ことができる。

【0058】尚、前記一般式KーIIで表されるイリジウ ム錯体および前記一般式KーIVで表されるイリジウム 錯体は、発光素子の材料として利用できる他、医療用 途、蛍光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー

色素、カラーフィルター用染料、色変換フィルター等に も使用可能である。

21

【0059】本発明の発光素子の別の形態は、陽極および陰極からなる一対の電極間に、発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物層を有する発光素子において、これらの層の少なくとも一層に、前記イリジウム化合物の少なくとも1種を含む発光素子である。前記イリジウム化合物は、高効率で青色発光する特性を有するので、発光層に含有させることによって、発光素子の発光効率を向上させることができる。また、前記イリジウム化合物は、良好な電荷輸送性能を有するので、電荷輸送層に含有させた場合も、発光素子の発光効率を向上させることができる。その結果、発光時の消費エネルギーを軽減できるとともに、高輝度の青色発光を長時間発光可能な発光素子を提供することができる。

【0060】前記発光素子は、前記電極間に発光層の他、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層 および保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。前記発光素子には、陰極と発光層との間にイオン化ボテンシャ 20 ル 5 . 9 e V以上(より好ましくは6 . 0 e V以上7 . 0 e V以下)の化合物を含有する層を配置するのが好ましく、イオン化ボテンシャル5 . 9 e V以上の電子輸送層を配置するのがより好ましい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることができる。前記発光素子において、前記イリジウム化合物は、発光層に発光材料として含有させることができるのはもちろん、電荷輸送層に含有させることができるのはもちろん、電荷輸送層に含有させることもできる。

【9061】前記イリジウム化合物を含有する層の形成 方法としては、特に限定されるものではないが、真空蒸 着法、LB法、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム法、スパッ タリング法、分子積層法、コーティング法(スピンコー ト法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジ エット法、印刷法などの種々の方法を利用することがで き、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティング法が 好ましい。特にコーティング法は、ディスプレイ用途等 の大面積化が必要な用途に供する場合に、製造コストが 軽減できる点で有利である。

【0062】前記コーティング法では、前記イリジウム 化合物を溶媒に溶解して塗布液を調製し、該塗布液を所 40 望の層(あるいは電極)上に、塗布・乾燥することによって形成することができる。塗布液中には樹脂を含有させてもよく、樹脂は溶媒に溶解状態とすることも、分散状態とすることもできる。前記樹脂としては、非共役系高分子(例えば、ボリビニルカルバゾール)および共役系高分子(例えば、ボリオレフィン系高分子)を使用することができる。より具体的には、例えば、ボリメチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルメタクリレート、ボリブチルステル、ポリスルホン、ボリフェニレンオキシド、ボリブタ 50 ジエン、ボリ(N・ビニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0063】前記陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光 層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属 酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物など を用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上 の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化瓶鉛、酸 化インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電 性金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の 金属。さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合 物または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点から1TOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である - が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは50nm~1µmであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0064】前記陽極は通常、ソーグライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが用いられる。前記透明基板としてガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーグライムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機械的独度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用いる。

【0065】前記陽極の作製には材料によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法(ブルーゲル法など)、酸化インジウムスズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極に洗浄またはその他の処理を施すことにより、発光素子の駆動電圧を下げたり、発光効率を高めることができる。例えばITOの場合、UVーオゾン処理、プラズマ処理などが効果的である。

【0066】前記陰極は電子注入層、電子輸送層、発光 層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子 輸送層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイ オン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰 極の材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属 酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用 いることができ、具体例としてはアルカリ金属(例えば Li、Na、K等)及びそのフッ化物または酸化物、ア

ルカリ土類金属(例えばMg、Ca等)及びそのフッ化 物または酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウ ムーカリウム合金またはそれらの混合金属、リチウムー アルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウ ムー銀合金またはそれらの混合金属、インジウム、イッ デリビウム等の希土類金属等が挙げられる。好ましくは 仕事関数が4eV以下の材料であり、より好ましくはア ルミニウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれら の混合金属、マグネンウムー銀合金またはそれらの混合 金属等である。前記陰極は、上記化合物及び混合物の単 10 層構造であってもよいし、上記化合物及び混合物を含む 積層構造であってもよい。例えば、アルミニウム/フッ 化リチウム、アルミニウム/酸化リチウム の積層構造 が好ましい。陰極の膜障は材料により適宜選択可能であ るが、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、 より好ましくは50nm~1µmであり、更に好ましく は100nm~1µmである。

【0067】前記陰極の作製には電子ビーム法、スパックリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以 20 上を同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調製した合金を蒸着させてもよい。両、前記陽極及び前記陸極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω/□以下であるのが好ましい。

【0068】前記発光層の材料は、電界印加時に陽極ま たは正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することが できると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電 子を注入することができる機能や、注入された質荷を移 動させる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光 30 させる機能を有する層を形成できるものであればいずれ でもよい。前記発光層は、前記イリジウム化合物を発光 材料として含有すると、高効率での青色発光が可能とな るので好ましい。但し、前記イリジウム化合物が発光層 以外の有機化合物層に含有される場合は、他の発光材料 を用いることができる。前記他の発光材料としては、例 えば、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール 誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘 導体、ボリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導 体、テトラフェニルプタジェン誘導体、ナフタルイミド 40 「誘導体」クマリン誘導体、パリレン誘導体、ペリノン誘 導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピ ラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチ リルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロ ピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロ ペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳香族ジ メチリディン化合物、8ーキノリノール誘導体の金属錯 体や希土類錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオ フェン、ボリフェニレン、ボリフェニレンビニレン等の ボリマー化合物、有機シラン誘導体等が挙げられる。発 50 光層には、前記イリジウム化合物とともに、前記他の発 光材料のいずれかを併用してもよい。

【0069】前記発光層には前記イリジウム化合物とともに、前記イリジウム化合物をゲスト材料とするホスト材料を含有させてもよい。前記ホスト材料としては、例えば、カルバゾール骨格を有するもの、ジアリールアミン骨格を有するもの、ピリジン骨格を有するもの、ピラジン骨格を有するもの、トリアジン骨格を有するもの等が挙げられる。前記ホスト材料のT,(最低三重環励起状態のエネルギーレベル)は、ゲスト材料のT,レベルより大きいことが好ましい。前記ホスト材料は低分子化合物であってもよい。前記ホスト材料とを共落着等することが好まして、前記発光材料が前記ホスト材料にドープされた発光層を形成することができる。

【0070】前記発光層の膜壁は特に限定されるものではないが、通常、 $1 \text{ nm} \sim 5 \mu \text{ m}$ であるのが好ましく。  $5 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ であるのがより好ましく、 $1 \text{ 0 nm} \sim 5$ 00 nmであるのが更に好ましい。

【0071】前記発光層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印刷法、LB法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸着、コーティング法である。

【0072】前記正孔注入層および前記正孔輸送層の材 料としては、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送 する機能、陰極から注入された電子を障壁する機能のい ずれか有しているものであればよい。その具体例として は、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサ ゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール 誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導 体、ビラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、ア リールアミン誘導体、アミノ體操カルコン誘導体、スチ リルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラ ゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香 族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族 ジメチリディン系化合物、ポルフィリン系化合物、ポリ シラン系化合物、ボリ (Nービニルカルバゾール) 誘導 体、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ボリ チオフェン等の導電性高分子オリゴマー、有機シラン誘 導体、前記イリジウム化合物等が挙げられる。前記正孔 注入層および前配正孔輸送層の膜障としては、特に限定 されるものではないが、通常1 n m~5 μ mであるのが 好ましく、 $5 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ であるのがより好ましく、1Onm~500nmであるのが更に好ましい。また、前 記正孔注入層および前記正孔輸送層は上述した材料の1 種または2種以上からなる単層構造であってもよいし。 間一組成または異種組成の複数層からなる多層構造であ

(14)

26

ってもよい。前記正孔注入層および前記正孔輸送層の形 成方法には、前記イリジウム化合物を含有する層の形成 方法で例示したのと間様の方法が利用できる。

25

【0073】前記電子注入層および前記電子輸送層の材 料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機 能、陽極から注入された正孔を障壁する機能のいずれか 有しているものであればよい。その具体例としては、ト リアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾ ール誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導 体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、 ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導 体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘 導体、ジスチリルビラジン誘導体、ナフタレン、ベリレ シ等の芳香環テトラカルボン酸無水物。フタロシアニン 誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフ タロシアニン、ペンゾオキサゾールやペンゾチアゾール を配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、有 機シラン誘導体、および前記イリジウム化合物等が挙げ られる。前記電子注入層および前記電子輸送層の膜厚は 特に限定されるものではないが、通常 1 n m ~ 5 u m で 20 あるのが好ましく、5 n m~1 μ m であるのがより好ま しく、10mm~500mmであるのが更に好ましい。 前記電子注入層および前記電子輸送層は上述した材料の 1種または2種以上からなる単層構造であってもよい。 し、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造 であってもよい。また、前記電子注入層および前記電子 輸送層の形成方法としては、前記イリジウム化合物を含 有する層の形成方法で例示したのと同様の方法が利用で \$ 8.

【0074】前記保護屬の材料としては、水分や酸素等 30 れた化合物は化合物例K-1であることが確認された。 の素子劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止す る機能を有しているものであればよい。その具体例とし TH, In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, T i、Ni等の金属、MgO。SiO、SiOz、AlzO s, GeO, NiO, CaO, BaO, FegOs, YgO i、TiO。等の金属酸化物、SiNa、SiNaO,等の 金属室化物、MgFi、LiF、AlFi、CaFi等の \*

\* 金属フッ化物、ボリエチレン、ボリブロビレン、ボリメ チルメタクリレート、ボリイミド、ボリウレア、ポリテ トラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレ ン、ポリジクロロジフルオロエチレン。クロロトリフル オロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合 体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノ マーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共 重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合 体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0、1%以下 10 の防湿性物質等が挙げられる。前記保護層の形成方法に ついても特に限定はなく、前記イリジウム化合物を含有 する層の形成方法で例示したのと同様の方法が利用でき Z).

【0075】本発明の発光素子は、表示素子、ディスプ レイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、 露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光 通信等の広い分野の用途に供することができる。

#### [0076]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明するが、本発 明は以下の実施例になんら限定されるものではない。

#### 【合成例1】

(化合物例K-1の合成) 2- (4-フルオロフェニ ル)ーピリジン 1、77g、トリスアセチルアセトナ トイリジウム(III) O. 5gおよびグリセロール 30m1を混合し、窒素気流下、200℃で4時間攪拌 した。室温まで冷却した後、メタノール 200mlを 加え、析出している個体を濾別した。シリカゲルカラム クロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し、淡黄色 脚体 O. 5gを得た。NMRを測定したところ、得ら 得られた化合物例K-1について、酸素脱気下、りん光 量子収率を測定したところ(トルエン溶媒、5.0×1 0°mo1/L) 90%であった。また、りん光の発光 極大波長2maxは477mmであった。

# [0077]

#### 【化17】

#### 【0078】 [合成例2]

(化合物例K-3の合成) 2-(2, 4-ジフルオロフ エコル)ービリジン 3、0g、トリスアセチルアセト ナトイリジウム(III) 1.3g、およびグリセロール 50mlを混合し、窒素気流下、200℃で4時間機 50 た化合物は化合物例K-3であることが確認された。得

**| 拌した。室温に冷却した後、メクノール200mlを加** え、析出している菌体を濾別した。シリカゲルカラムク ロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し、淡黄色間 体 0.8gを得た。NMRを測定したところ、得られ

られた化合物例K-3について、酸素脱気下、りん光量 子収率を測定したところ(トルエン溶媒、5.0×10

\*大波長 lmaxは470 nmであった。

[0079]

【化18】

(15)

# [0080] [合成例3]

(化台物例K-9の合成) 化台物 a 0,2g、アセチ ルアセトン 0,07mlにクロロホルム 10mlを 加え、この溶液に、ナトリウムメトキサイドのメタノー ル溶液 (28質量%)を0.13ml加え、還流下6時 間撹拌した。室温に冷却した後、クロロホルム 50m 1、水 50m1を加え、有機層を分離した。シリカゲ※ ※ルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製 し、淡黄色関体 O. Igを得た。NMRを測定したと ころ、得られた化合物は化合物例K-9であることが確 認された。

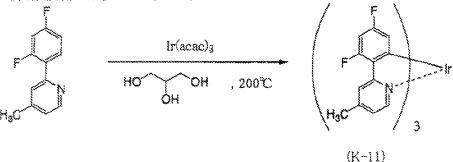
[0081] [化19]

# 【0082】[合成例4]

(化合物例K-11の合成) 2-(2, 4-ジフルオロ フェニル)ー4ーメチルビリジン 1、0g、トリスア セチルアセトナトイリジウム(III) 0.4g、グリ セロール 30mlを混合し、窒素気流下、200℃で 30 4時間攪拌した。室温に希却した後、水 200mlを 加え、析出している個体を適別した。シリカゲルカラム★

★クロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し、淡黄色 個体 O. 2gを得た。NMRを測定したところ、得ら れた化合物は化合物例K-11であることが確認され to

[0083] [化20]



【0084】 [比較例1] 洗浄したITO基板を蒸着装 置内に格納し、 $\alpha$ -NPD (N, N'ージフェニルー  $N, N' \rightarrow \emptyset$  ( $\alpha - f \gamma f \lambda$ )  $- \kappa \lambda \beta \beta \lambda \lambda$ )  $\delta 40 n$ m蒸着し、その上に、下記に示す化合物Aおよび化合物 Bを(質量比10:1)の比率で24nm共蒸着し、さ らにその上に、化合物Eを24nm蒸着し、有機薄膜を 形成した。この有機薄膜上にパターニングしたマスク (発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、

蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共 50

蒸着した後、銀50nmを蒸着し、有機EL素子を作製 した。尚、化合物Bについて、化合物例K-1と同一条 件下でりん光量子収率を測定したところ、りん光量子収 率は70%であり、りん光の発光極大波長えmaxは5 07 nmであった。

[0085]

【化21】

(Applied Physics Letters vol. 75. No1, 5 July 1999: #20€)

[0086] [化22] (**Lam**E

【0087】得られた有機EL素子について、東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、直流定電圧を印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝 30度計BM-8を用いて、および発光波長を浜松フォトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて制定した。その結果、発光波長2maxが516nm、CIE色度値(x,y)=(0.29,0.62)である緑色発光が得られ、その外部量子効率は13.6%であった。

【0088】 [比較例2] 比較例1において、化合物B の代わりに下記に示す化合物Cを用い、比較例1と同様に有機EL素子を作製し、評価した。その結果、発光極大波長えmaxが505nm、CIE色度値(x,y) 40 = (0.27,0.57) である緑色発光が得られ、外部最子効率は3.3%であった。

[0089] [他23]

化合物C Polymer Preprints 2000, 41(1),770に記載

【0090】比較例1および2の結果から明らかな様に、公知のオルトメタル化イリジウム錯体を含有する有機EL素子では、緑色発光しか得られなかった。

【0091】 [比較例3] 洗浄した I T O 基板を蒸着装置に入れ、α-NPD(N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(α-ナフチル)ーベンジジン)を40 n m 蒸着し、その上に、下記に示す化合物F(DPVBi)を20 n m 蒸着し、さらにその上に、前記化合物Eを40 n m 蒸着し、その後、比較例1と同様に陰極を蒸着し、10 有機E L 素子を作製した。得られた有機E L 素子について、実施例1と同様に、直流定電圧を印加し発光させたところ、C I E 色度値(x, y)=(0.15,0.20)の青色発光が得られたが、外部量子効率は1.2%と低かった。この様に公知の青色発光素子では、外部量子効率が低く、5%をはるかに下囲るものであった。

[0092]

[化24]

20

【0093】[実施例1]比較例1において、化合物Bの代わりに化合物例K-1を使用し、比較例1と間様に有機E1案子を作製し、評価した。その結果、発光極大波長λmaxが486nm、CIE色度値(x, y)=(0.18,0、49)である青色発光が得られ、外部量子効率は5.8%であった。

【0094】 [実施例2] 比較例1において、化合物Bの代わりに化合物例K-1を使用し、化合物Aの代わりに化合物Dを用い、比較例1と開様に有機EL素子を作製し、評価した。その結果、発光極大波長2maxが487nm、CIE色度値(x, y) == (0.22,0.53) である青色発光が得られ、外部量子効率は10.5%であった。

[0095]

【化25】

の上に化合物例K-1および上記化合物Dを(質量比 1:17)の比率で36nm共蒸着し、さらにその上 に、上記化合物Gを36nm蒸着し、有機薄膜を形成した。この有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面 積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置 内でフッ化リチウムを3nm蒸着した後、アルミニウム を40nm蒸着し、有機EL素子を作製した。その結果、発光極大波長 $\lambda$ maxが485nm、CIE色度値(x,y)=(0.19,0.51)である青色発光が 得られ、外部量子効率は19.1%であった。

31

[0097]

【化26】

化含物()

【0098】 [実施例4] 実施例3において、化合物例 K-1の代わりに化合物例K-3を用い、実施例3と問 様に有機EL業子を作製し、評価した。その結果、発光\* \* 極大波長 2 m a x が 4 7 3 n m、C I E 色度値(x,y) = (0.15,0.37) の青色発光が得られ、 外部量子効率は12.9%であった。

【0099】 [実施例5] 実施例3において、化合物例 K-1の代わりに化合物例K-9を用い、実施例3と間 様に有機BL素子を作製し、評価した。その結果、発光 極大波長 l m a x が 4 8 0 n m、C l E 色度値(x,

y) = (0, 20, 0, 52) の青色発光が得られ、外部量子効率は11, 4%であった。

10 【0100】 同様に、本発明の化合物を含有するEL案 子を作製・評価することにより、高効率青色発光EL案 子が作製できる。また、非共役系高分子(例えば、ポリ ビニルカルバゾール)、共役系高分子(例えばポリフル オレン系化合物)などを含有する塗布型の高効率青色発 光素子も作製できる。

#### [0101]

フロントページの続き

(72) 発明者 富下 場介

神奈川県南足柄市中福210番地 富士写真 フイルム株式会社内

(72)発明者 藤村 秀俊

神奈川県南足柄市中宿210番地 富士写真 フイルム株式会社内

(72) 発明者 岡田 久

神奈川県南足柄市中昭210番地 富士写真 フイルム株式会社内 (72) 発明者 三島 雅之

神奈川県南足柄市中昭210番地 富士写真 フイルム株式会社内

(72) 発明者 邱 雪鵬

神奈川県南足栖市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB08 AB13

BBOS CAOI CAOS CBOI DAOO

DB03 EB00 FA01

4C055 AA01 BA02 BA08 BA13 BB14

CAOL DAOL

4H050 AA01 AA03 AB92 WB11 WB13 WB14 WB21

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

 $\mathbf{E}$ 

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】 平成18年6月1日(2006, 6, 1)

【公開番号】特開2002-117978(P2002-117978A)

【公開日】 平成14年4月19日(2002, 4, 19)

【出願番号】特願2001-189539(P2001-189539)

【国際特許分類】

H O 1 L 51/50 (2006.01) C O 7 D 213/61 (2006.01) C O 9 K 11/06 (2006.01) H O 5 B 33/10 (2006.01) C O 7 F 15/00 (2006.01)

TEIT

H 0 5 B 33/14 B C 0 7 D 213/61

C 0 9 K 11/06 6 6 0 H 0 5 B 33/10

C O 7 F 15/00

【提出日】平成18年4月10日(2006.4.10)

【手続補正1】

[手続補正書]

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0096

【辅正方法】変更

【補正の内容】

[0096]

[実施例3]

洗浄した1TO基板を蒸着装置に入れ、TPD(N,N'ージフェニルーN,N'ージ(mートリル)ーベンジジン)を50nm蒸着し、その上に化合物例K-1および上記化合物Dを(質量比1:17)の比率で36nm共蒸着し、さらにその上に、次に示す化台物Gを36nm蒸着し、有機薄膜を形成した。この有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウムを3nm蒸着した後、アルミニウムを40nm蒸着し、有機EL素子を作製した。その結果、発光板大波長えmaxが485nm、CIE色度値(x,y)=(0.19,0.51)である青色発光が得られ、外部量子効率は19.1%であった。